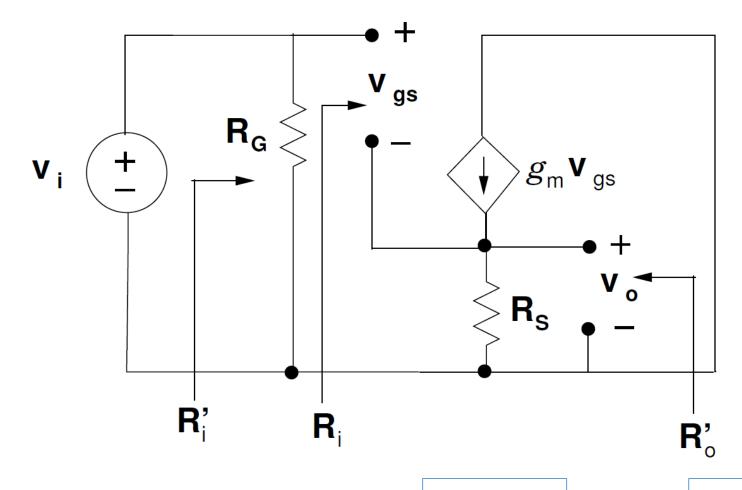
# Elettronica Digitale A.A. 2020-2021

Lezione 15/04/2021

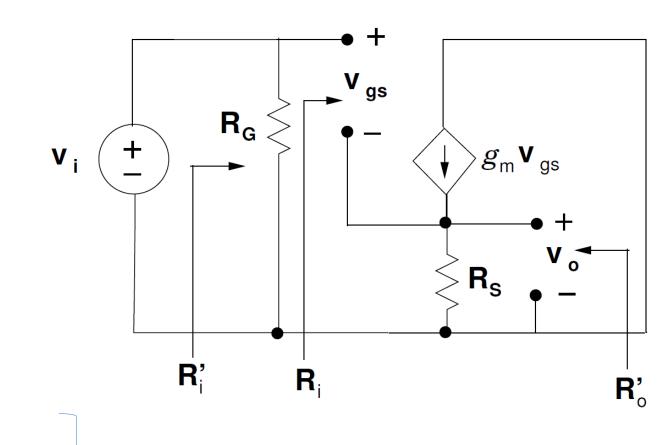
# Stadio amplificatore a drain comune



$$R_o = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o' = \frac{1}{g_m} || R_S$$

## Stadio amplificatore a drain comune



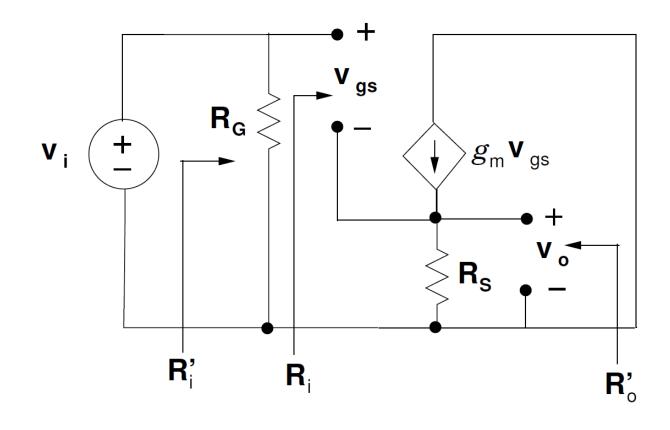
$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{i}}$$

$$v_o = g_m v_{gs} R_S$$

$$v_{gs} = \frac{v_i}{\left(1 + g_m R_S\right)}$$

$$A_{v} = g_{m}R_{S} \frac{v_{i}}{(1 + g_{m}R_{S})} \frac{1}{v_{i}} = \frac{g_{m}R_{S}}{(1 + g_{m}R_{S})}$$

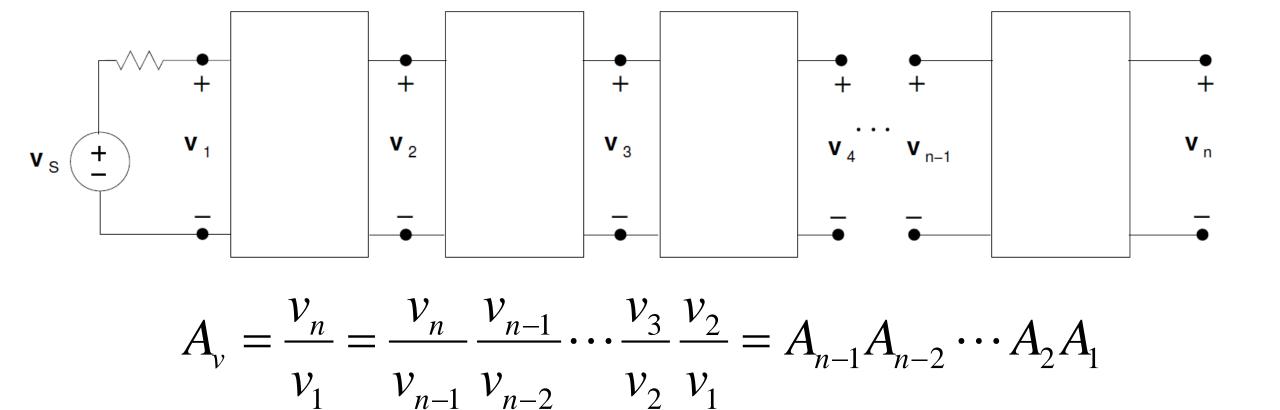
## Stadio amplificatore a drain comune



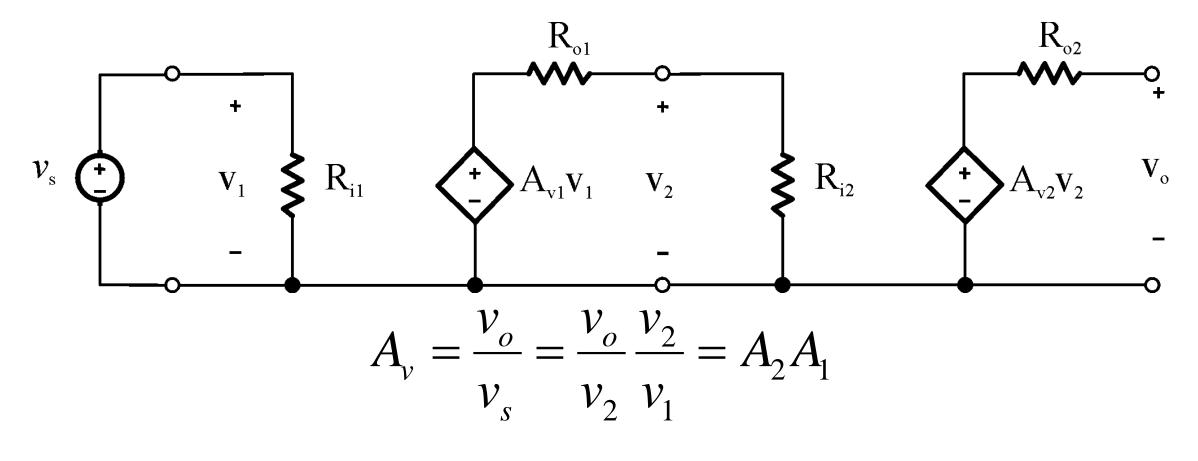
$$A_{v} = \frac{g_{m}R_{S}}{\left(1 + g_{m}R_{S}\right)}$$

Se 
$$(g_m R_S) \gg 1 \implies A_v \approx 1$$

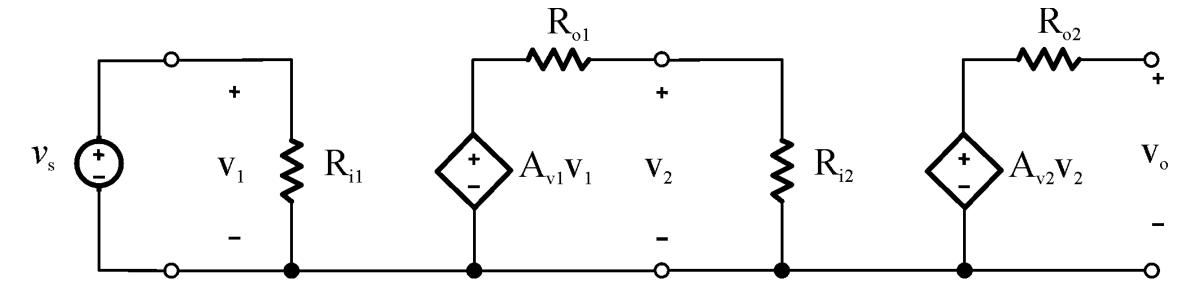
Inseguitore di source (Source follower)



I guadagni che compaiono nel prodotto non sono quelli calcolati per i singoli stadi isolati, ma devono tenere conto dell'interazione tra gli stadi stessi.



$$v_2 = A_{v1}v_1 \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}}$$
  $A_1 = \frac{v_2}{v_1} = A_{v1} \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}}$ 



$$A_1 = A_{v1} \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}}$$

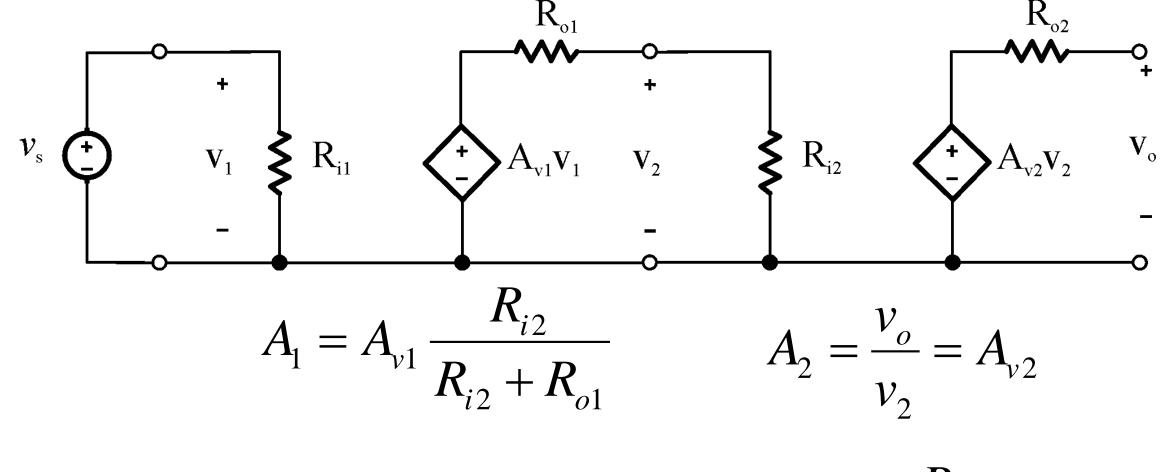
$$A_1 \neq A_{v1}$$

$$\begin{cases} R_{o1} = 0 \\ \text{oppure} \\ R_{i2} = \infty \end{cases}$$

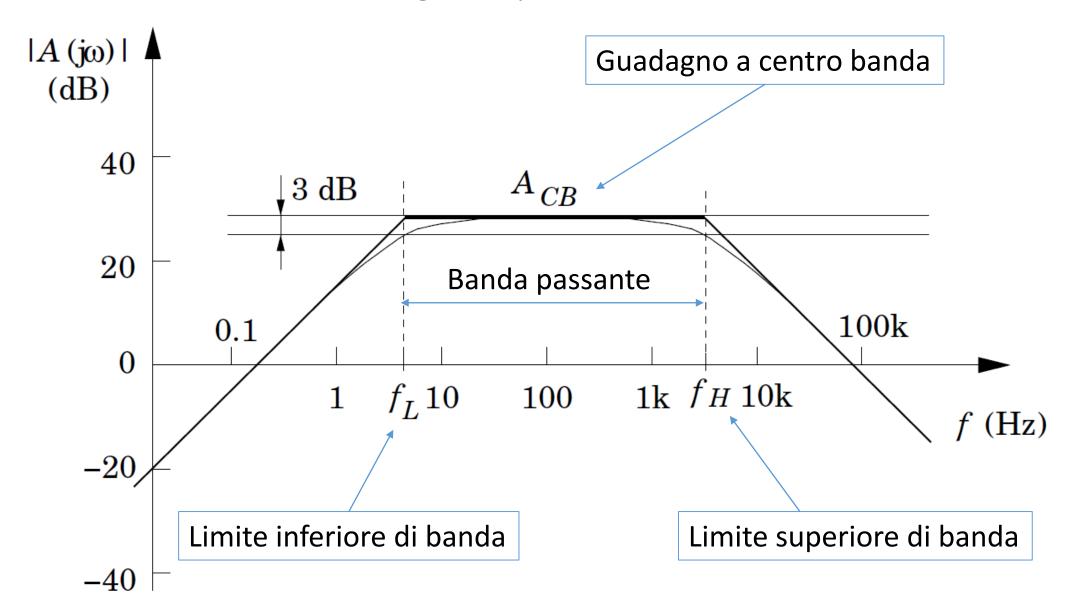


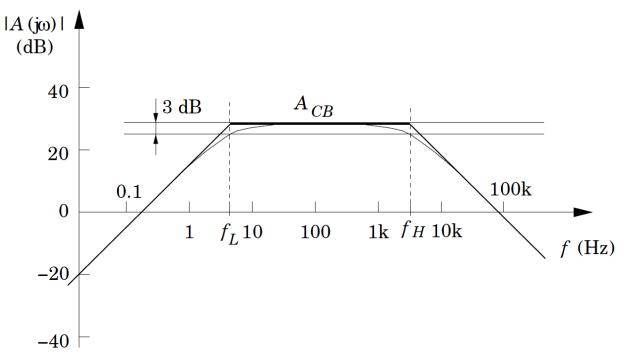
$$A_1 = A_{v1}$$

Lo stadio a "valle" non carica lo stadio a "monte"



$$A_{v} = \frac{v_{o}}{v_{s}} = \frac{v_{o}}{v_{2}} \frac{v_{2}}{v_{1}} = A_{2}A_{1} = A_{v1}A_{v2} \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_{o1}}$$





Se i poli e gli zeri che determinano il comportamento dell'amplificatore ad alta frequenza sono ben separati (almeno un paio di decadi) da quelli che caratterizzano il comportamento a bassa frequenza, la funzione di trasferimento dell'amplificatore può essere scritta nella forma

$$A(s) = \frac{V_U(s)}{V_{IN}(s)} = A_{CB}F_L(s)F_H(s)$$

$$A(s) = \frac{V_U(s)}{V_{IN}(s)} = A_{CB}F_L(s)F_H(s)$$

Bassa frequenza

$$A(s) \approx A_{CB}F_L(s)$$

$$F_{L}(s) = \frac{\left(s + \omega_{z_{1}}\right)\left(s + \omega_{z_{2}}\right)\cdots\left(s + \omega_{z_{m'}}\right)}{\left(s + \omega_{p_{1}}\right)\left(s + \omega_{p_{2}}\right)\cdots\left(s + \omega_{p_{n'}}\right)}$$

I poli e gli zeri che determinano il comportamento a bassa frequenza sono di solito quelli relativi agli elementi reattivi (condensatori e induttanze) esterni ai componenti elettronici.

$$A(s) = \frac{V_U(s)}{V_{IN}(s)} = A_{CB}F_L(s)F_H(s)$$

Alta frequenza

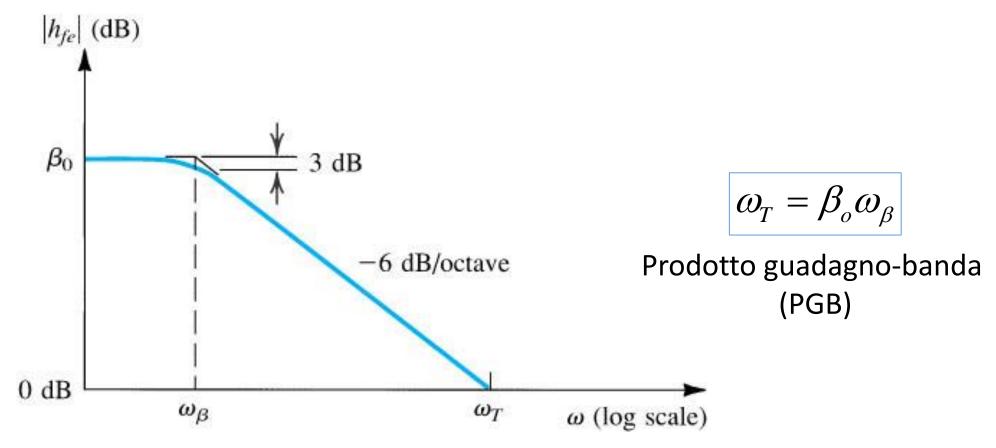
$$A(s) \approx A_{CB}F_H(s)$$

$$F_{H}(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{z_{1}'}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{z_{2}'}}\right)\cdots\left(1 + \frac{s}{\omega_{z_{m''}}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{p_{1}'}}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{p_{2}'}}\right)\cdots\left(1 + \frac{s}{\omega_{p_{n''}}}\right)}$$

I poli e gli zeri che determinano il comportamento ad alta frequenza sono di solito quelli relativi ai condensatori interni ai componenti elettronici.

# Limite di funzionamento ad alta frequenza: la frequenza di transizione

Per un transistore bipolare, la frequenza di transizione ( $f_T$ ) è la frequenza a cui il guadagno di corrente di cortocircuito dell'amplificatore nella configurazione a emettitore comune diviene unitario



## Limite di funzionamento ad alta frequenza: la frequenza di transizione

Per un transistore MOSFET, la frequenza di transizione ( $f_T$ ) è la frequenza a cui il guadagno di corrente di cortocircuito dell'amplificatore nella configurazione a source comune diviene unitario

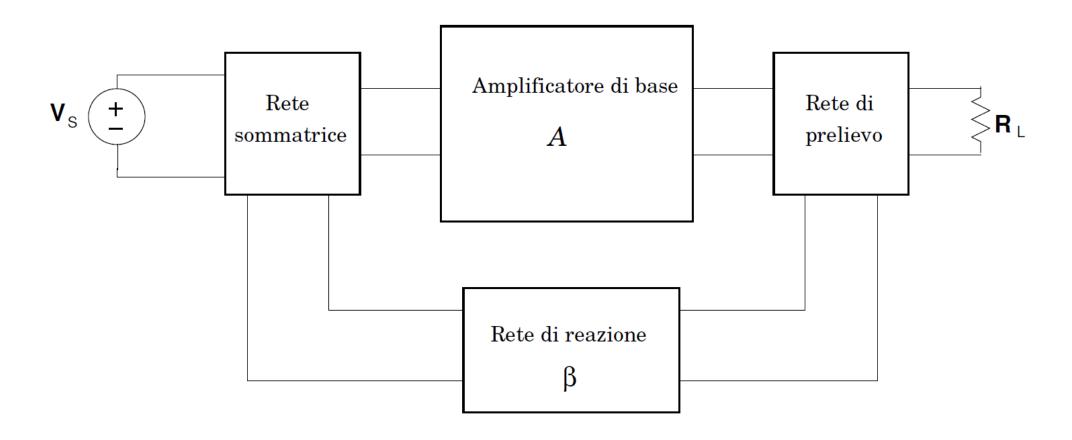
$$f_{\scriptscriptstyle T} \propto \mu rac{V_{\scriptscriptstyle T}}{W_{\scriptscriptstyle R}^2}$$
 BJT

$$f_T \propto \mu \frac{V_{GS} - V_T}{L^2}$$
 MOSFET

Il principio della reazione consiste nel riportare all'ingresso di un sistema una porzione del segnale in uscita, in modo da modificare le proprietà del sistema stesso.

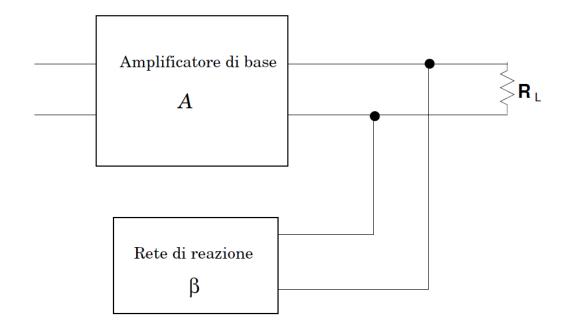
In tutti quei casi nei quali lo scopo è quello di mantenere una grandezza costante, la reazione che si realizza è di tipo negativo, vale a dire che il segnale riportato in ingresso ha segno rovesciato rispetto a quello del segnale di ingresso che lo ha prodotto. In questo modo ogni variazione determina un effetto a essa opposto, che tende a contrastarla.

In campo elettronico la reazione utilizzata è di solito negativa, anche se gli scopi per cui viene realizzata sono ben più vari che della semplice regolazione di una grandezza.

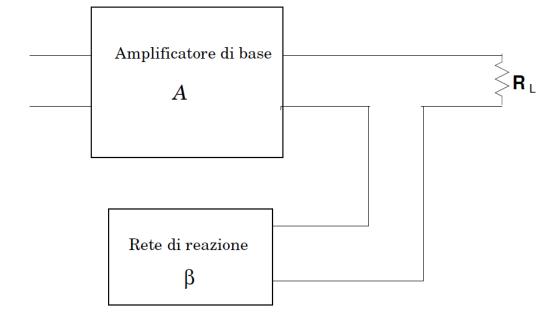


Tipologie di prelievo del segnale d'uscita

#### Prelievo di tensione

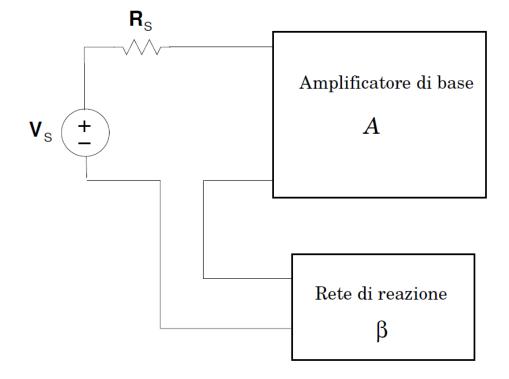


#### Prelievo di corrente

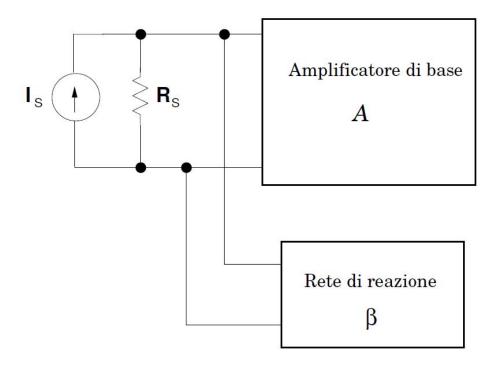


Tipologie di re-inserzione del segnale in ingresso

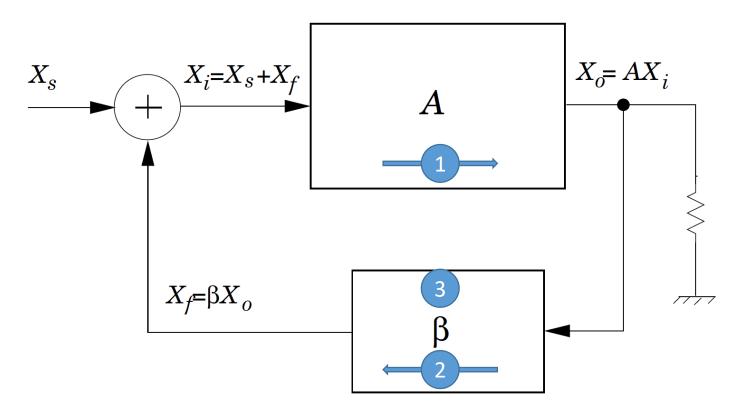
#### Inserzione serie



#### Inserzione parallelo

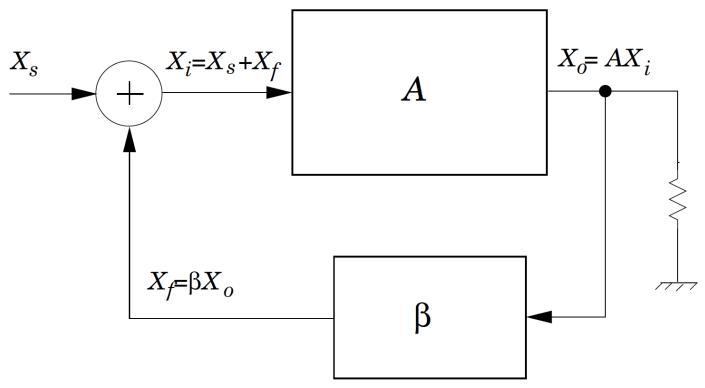


Rappresentazione generale di una rete in reazione



Ipotesi semplificative:

- 1. L'amplificatore è unidirezionale
- 2. La rete di reazione è unidirezionale
- 3. Il fattore di reazione  $\beta$  è indipendente dalla resistenza della sorgente e da quella del carico



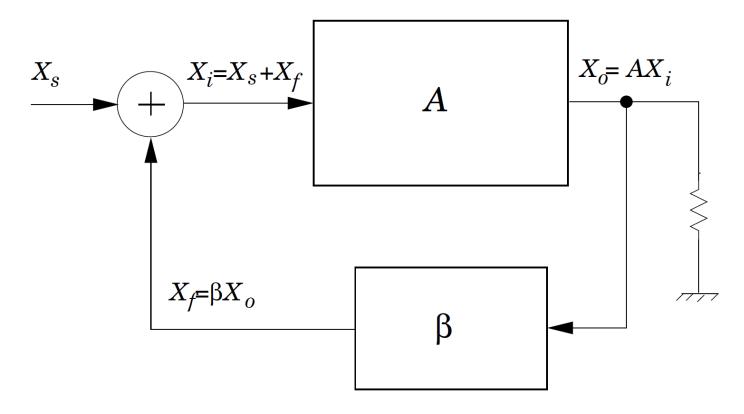
$$X_{i} = X_{s} + X_{f}$$

$$X_{i} = X_{s} + \beta X_{o}$$

$$X_{i} = AX_{s} + \beta X_{o}$$

$$X_{o} = AX_{i}$$

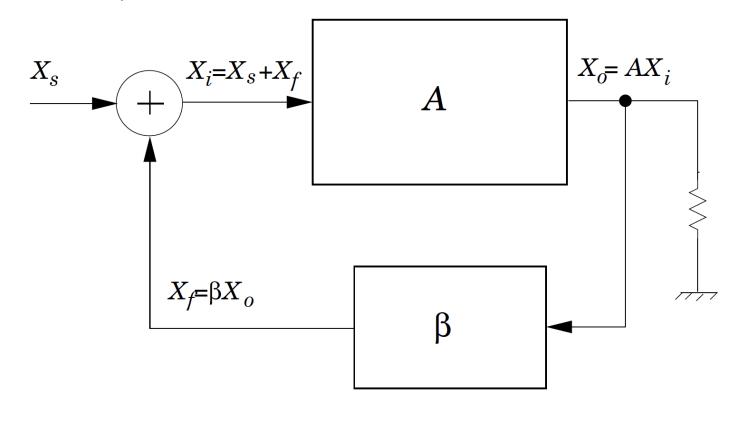
$$X_{o} = A(X_{s} + \beta X_{o}) \Rightarrow \frac{X_{o}}{X_{s}} = \frac{A}{1 - \beta A}$$



Guadagno ad anello aperto

$$|\beta A|$$
 Guadagno d'anello

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 - \beta A}$$
 Guadagno ad anello chiuso



$$|A_f| < |A|$$
 Reazione negativa

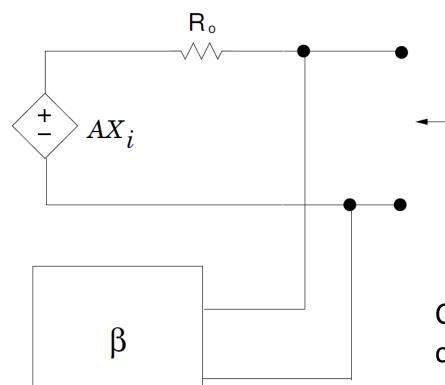
$$|A_f| > |A|$$
 Reazione positiva

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 - \beta A}$$

Se 
$$|\beta A| \gg 1$$

$$A_f \approx -\frac{1}{\beta}$$

Effetto della reazione sull'impedenza di uscita in presenza di una reazione di tensione



$$R_{of} = \frac{\text{tensione a vuoto}}{\text{corrente di cortocircuito}} = \frac{V_o}{I_{sc}}$$

In assenza di un carico collegato in uscita

$$V_o = \frac{A}{1 - \beta A} X_s$$

Con un carico di valore nullo collegato in uscita (corto circuito) la reazione è nulla

$$I_{sc} = \frac{AX_i}{R_o} = \frac{AX_s}{R_o}$$

$$A_f = \frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 - \beta A}$$

$$R_{of} = \frac{V_o}{I_{sc}} = \frac{A}{1 - \beta A} X_s \frac{R_o}{AX_s}$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 - \beta A}$$